

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成17年10月27日(2005.10.27)

【公開番号】特開2004-59990(P2004-59990A)

【公開日】平成16年2月26日(2004.2.26)

【年通号数】公開・登録公報2004-008

【出願番号】特願2002-219328(P2002-219328)

【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 14/50

C 2 3 C 16/458

C 2 3 C 16/46

// H 0 1 L 21/68

【F I】

C 2 3 C 14/50 E

C 2 3 C 14/50 F

C 2 3 C 16/458

C 2 3 C 16/46

H 0 1 L 21/68 N

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月29日(2005.7.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】成膜装置及び方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被処理基板を保持する円形のトレーと、前記トレーに対向して配置され前記被処理基板を加熱する発熱体とを有する成膜装置であって、前記トレーは外周から中心に向かって複数のスリットを有し、前記スリットを塞ぐように前記トレーと前記発熱体との間にプレートが設けられたこと

を特徴とする成膜装置。

【請求項2】

前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴とする請求項1記載の成膜装置。

【請求項3】

前記材料はC U - A Lであることを特徴とする請求項2に記載の成膜装置。

【請求項4】

真空チャンバー内に配置された被処理基板を前記被処理基板に対向して設けられた発熱体で加熱しながら前記被処理基板を処理する成膜方法であって、前記真空チャンバー内に設けられたピンを突き上げることで、前記被処理基板を保持しながら前記被処理基板を処理することを特徴とする成膜方法。

【請求項 5】

前記発熱体と前記被処理基板との距離が5mm以内であることを特徴とする請求項4記載の成膜方法。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記した目的を達成するために、請求項1に記載された成膜装置は、被処理基板を保持する円形のトレーと、前記トレーに対向して配置され前記被処理基板を加熱する発熱体とを有する成膜装置であって、前記トレーは外周から中心に向かって複数のスリットを有し、前記スリットを塞ぐように前記トレーと前記発熱体との間にプレートが設けられたことを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、請求項2に記載された成膜装置は、請求項1における成膜装置において、前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴する。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

また、請求項3に記載された成膜装置は、請求項2における成膜装置において、記材料はCUALであることを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0014】

また、請求4に記載された成膜方法は、真空チャンバー内に配置された被処理基板を前記被処理基板に対向して設けられた発熱体で加熱しながら前記被処理基板を処理する成膜方法であって、前記真空チャンバー内に設けられたピンを突き上げることで、前記被処理基板を保持しながら前記被処理基板を処理することを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

更に、請求5に記載された成膜方法は、請求項4における成膜方法において、前記トレーの被処理基板を載置する面に成膜材料と同じ熱膨張率の材料を積層したことを特徴とす

る。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】削除

【補正の内容】